05,12

Температурная зависимость магнитных свойств и магнитополевого поведения тонкопленочных трехслойных Co/Gd/Co систем

© А.М. Харламова¹, А.В. Макаров¹, А.В. Свалов², Е.Е. Шалыгина^{1,¶}

¹ Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

Москва, Россия

² Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,

Екатеринбург, Россия

[¶] E-mail: Shalygina.ee@gmail.com

Поступила в Редакцию 3 июня 2021 г. В окончательной редакции 3 июня 2021 г. Принята к публикации 3 июня 2021 г.

Представлены результаты исследований температурных зависимостей магнитных свойств и магнитополевого поведения тонкопленочных трехслойных Co/Gd/Co систем, полученных методом ионно-плазменного магнетронного распыления. Толщина слоев кобальта равна 5.0 nm, а слоев Gd, t_{Gd} , изменяется от 3.0 до 10.0 nm. Объемные магнитные характеристики образцов измерены на вибрационном магнитометре при ориентации внешнего магнитного поля параллельно плоскости образцов. Обнаружено влияние температуры и толщины Gd слоя на форму петель гистерезиса, значения магнитного момента m и коэрцитивной силы H_C . В частности, при изменении температуры от 100 до 300 К наблюдается уменьшение коэрцитивной силы, а при температуре больше 150 К увеличение магнитного момента. С ростом толщины гадолиния значение m уменьшается.

Ключевые слова: магнитные свойства, магнитополевое поведение, низкотемпературные измерения, редкоземельные металлы, тонкопленочные структуры.

DOI: 10.21883/FTT.2021.10.51402.136

1. Введение

Исследования тонкопленочных систем, содержащих 3d-переходные металлы (TM — Transition Metals) и редкоземельные металлы (REM — Rare Earth Metals), а также их сплавы являются актуальными в течение многих лет. Интерес к этим системам обусловлен высокими значениями магнитных моментов REM и, как следствие этого, перспективой их широкого практического применения [1].

Для указанных выше многослойных TM/REM структур наблюдается многообразие магнитных свойств, что предопределяет их активное применение, в практических приложениях, в частности, в магнитооптических записывающих устройствах [2]. Кроме того, ферромагнитные мультислойные REM/TM системы представляют интерес как модельные образцы при изучении обменного взаимодействия между REM (Gd, Dy, Tb и др.) и ТМ (Со, Fe) слоями, магнитное состояние которых в основном определяется конкуренцией обменной энергии и энергии Зеемана. Такие многослойные системы характеризуются антиферромагнитной межслойной связью между REM и TM. Фактически они представляет собой искусственные ферримагнетики с различными основными состояниями. Накопленный объем экспериментальных и теоретических данных значительно расширил представления о низкоразмерных магнитных материалах. В частности, установлено, что качество и свойство поверхности ферромагнитных материалов существенно влияют на их магнитные характеристики [3].

Обнаружена сильная зависимость магнитных свойств ультратонких магнитных пленок кобальта (Со) от их толщины, а также от толщины и состава немагнитного слоя, напыленного между пленкой и подложкой [4]. Вместе с тем по-прежнему особого внимания заслуживают тонкопленочные системы на основе кобальта и редкоземельного гадолиния, что обусловлено следующими фактами. Ранее было установлено, что межслойное обменное взаимодействие в многослойных системах REM/TM подобно взаимодействию, существующему в REM/TM сплавах между магнитными моментами атомов REM и ТМ [1,5]. При этом следует иметь в виду, что магнитное упорядочение в RE металлах обусловлено дальнодействующим косвенным обменным взаимодействием, осуществляющимся через электроны проводимости. Вследствие этого магнитные свойства REM сильно зависят от структурного состояния реальных объектов [6]. При изучении тонкопленочных образцов с редкоземельными металлами наиболее активно используются слоистые металлические структуры, характеризующиеся высокими температурами магнитного упорядочения. Следует отметить, что среди REM гадолиний имеет самую высокую температуру (T) магнитного упорядочения (температура Кюри — $T_{\rm C} = 293$ K). Кроме того, он является коллинеарным ферромагнетиком во всем температурном диапазоне ниже T_C. При понижении температуры ниже точки Кюри возникает ферромагнитная структура с ориентацией магнитного момента вдоль с-оси кристаллической решетки, которая сохраняется до 240 К. При Т меньше 240 К магнитный момент отклоняется от с-оси на некоторый угол, значение которого увеличивается при дальнейшем понижении температуры [6].

Анализ существующих данных показал, что большинство ранних исследований были в основном посвящены изучению многослойных структур на основе гадолиния. При интерпретации полученных экспериментальных данных, наблюдаемых для вышеуказанных образцов, приходилось учитывать наличие в слоистых структурах повторяющихся периодов. Было доказано, что для более корректного изучения магнитополевого поведения тонкопленочных систем, в частности, систем с гадолинием, целесообразно использовать трехслойные образцы [7]. При этом следует иметь в виду, что на сегодняшний день Gd, как в объемном, так и в тонкопленочном состоянии, остается наиболее перспективным материалом для практических приложений [8,9]. Ранее выполненные авторами данной работы исследования при комнатной температуре [10], показали, что форма петель гистерезиса и значение поля насыщения H_S трехслойных Co/Gd/Co зависят от толщины гадолиниевого слоя. Учитывая перспективность практического применения Co/Gd/Co образцов, изучение влияния температуры на магнитные свойства и магнитополевое поведение трехслойных Co/Gd/Co систем заслуживало внимания.

Актуальность экспериментальных исследований магнитных характеристик слоистых образцов с REM прослойкой, в частности, Co/Gd/Co систем при различных температурах, объясняется также необходимостью получения данных, востребованных при разработке новых слоистых структур для современных устройств микрои наноэлектроники. Принимая во внимание все вышеприведенные факты, можно с уверенностью утверждать, что получение новой информации о свойствах Co/Gd/Co тонкопленочных систем актуально, как с фундаментальной, так и практической точки зрения.

Цель настоящей работы — исследование влияния температуры (T) при изменении T от 100 до 300 K на магнитные свойства и магнитополевое поведение трехслойных тонкопленочных Co/Gd/Co систем, состоящих из двух одинаковых слоев кобальта и редкоземельной гадолиниевой прослойки разной толщины.

2. Образцы и методики исследования

Изучаемые трехслойные Co/Gd/Co образцы были получены при комнатной температуре методом ионноплазменного магнетронного распыления на неохлаждаемые стеклянные подложки Corning 2845 с использованием Та, Co и Gd мишеней. Перед процедурой напыления все подложки последовательно очищались в ультразвуковой ванне ацетоном, этанолом и деионизированной водой, а затем сушились при температуре 100°C. Шероховатость поверхности подложки была порядка 0.5 nm. В качестве буферного подслоя и верхнего слоя, защищающего образцы от окисления, наносились слои тантала (Ta) толщиной 5.0 nm. Базовое давление в вакуумной камере было $4.0 \cdot 10^{-7}$ mbar. Давление аргона в процессе напыления пленки достигало $3.8 \cdot 10^{-3}$ mbar. Изготовление образцов осуществлялось при наличии магнитного поля $H_{\rm SUB} = 250$ Oe, приложенного параллельно плоскости подложки. Это предопределяло формирование плоскостной одноосной магнитной анизотропии.

Толщина слоев кобальта, $t_{\rm Co}$, во всех трехслойных Co/Gd/Co образцах была равна 5.0 nm, а Gd, $t_{\rm Gd}$ — 3.0, 4.6, 6.0, 7.0, 9.0 и 10.0 nm. Толщина слоев была определена по скорости (11.0, 2.6 и 2.8 nm/min для Та, Co и Gd соответственно) и времени напыления для каждого материала. Скорость напыления была определена также с помощью атомной силовой микроскопии (AFM). Разница значений толщины, полученных обеими методиками, не превышала 5%.

При выполнении низкотемпературных измерений, в отличие от выполненных нами ранее исследований [10], изучаемые образцы имели линейные размеры 5×5 mm (вместо 10×10 mm), что было обусловлено особенностями низкотемпературной экспериментальной установки.

Объемные магнитные характеристики Co/Gd/Co трехслойных образцов были измерены на вибрационном магнитометре "Lake Shore VSM 7400" с чувствительностью 10^{-5} ети. Внешнее перемагничивающее магнитное поле было приложено параллельно плоскости образца. Методы измерений магнитных характеристик изучаемых образцов на вибрационном магнитометре подробно описаны в работе [11]. Установка позволяет проводить измерения намагниченности в широком диапазоне температур с использованием различных температурных приставок. В данном случае для проведения низкотемпературных измерений используется продувной криостат. Принцип действия приставки основан на продуве хладагента через объем, в котором находится исследуемый образец. В качестве хладагента использовались пары жидкого азота.

Измерения петель гистерезиса были выполнены в температурном диапазоне от 100 до 300 К. Стабильность температуры при выполнении измерений сохранялась в интервале 0.1–1.0 К и определялась из соотношения — необходимая точность/длительность измерений. Исследуемый образец крепился на шток из стекловолокна ("fiberglass") при помощи медицинского клея. Этот способ вносит минимальный вклад диамагнитного сигнала в суммарный магнитный момент и позволяет работать в диапазоне температур от 4.2 К до 450 К [12].

3. Результаты исследований и их обсуждение

Результаты проведенных рентгеноструктурных исследований свидетельствовали о том, что слои кобальта во всех изучаемых образцах имеют нанокристаллическую структуру. Кроме того, измерения, выполненные с помощью атомного силового микроскопа, показали, что в случае образцов размером 5×5 mm средняя шероховатость их поверхности, R_a , также как и для ранее изучаемых образцов размером 10×10 mm не превышает



Рис. 1. Типичные петли гистерезиса, наблюдаемые для изучаемых Co/Gd/Co образцов размером 5 × 5 mm при комнатной температуре в магнитном поле, приложенном параллельно оси легкого намагничивания.



Рис. 2. Типичные петли гистерезиса, наблюдаемые для изучаемых Co/Gd/Co образцов размером 10 × 10 mm при комнатной температуре в магнитном поле, приложенном параллельно оси легкого намагничивания.



Рис. 3. Зависимости поля насыщения HS, наблюдаемые при комнатной температуре для изучаемых Co/Gd/Co образцов с линейными размерами $5 \times 5 \,\mathrm{mm}$ и $10 \times 10 \,\mathrm{mm}$ с различной толщиной Gd слоя.

0.5 nm, и практически не зависит от толщины Gd слоя. Это свидетельствовало о том, что толщина слоя гадолиния в основном не влияет на свойства поверхности исследуемых образцов, а, следовательно, шероховатость поверхности не должна оказывать влияние на магнитные характеристики Co/Gd/Co тонкопленочных систем.

Измерения петель гистерезиса Co/Gd/Co образцов были выполнены на вибрационном магнетометре при двух ориентациях внешнего магнитного поля, приложенного параллельно поверхности образцов. В одном случае направление H было параллельно ориентации магнитного поля, приложенного в процессе напыления образцов (направление D1), а в другом — перпендикулярно D1 (направление D2). Было обнаружено, что, как и в случае, ранее изучаемых нами образцов с линейными размерами $10 \times 10 \text{ mm}$ [10], форма петель гистерезиса при комнатной температуре и ориентации магнитного поля параллельно D1 и D2 различаются. Этот факт свидетельствовал о наличии наведенной магнитной анизотропии (MA) с осью легкого намагничивания (EA), параллельной



Рис. 4. Петли гистерезиса, наблюдаемые для образца с $t_{Gd} = 3.0$ nm при T = 100 K и 150 K (a), T = 200 K и 250 K (b), T = 270 K и 300 K (c) в магнитном поле, приложенном параллельно оси легкого намагничивания.



Рис. 5. Петли гистерезиса, наблюдаемые для образца с $t_{Gd} = 4.6$ nm при T = 100 K (a), T = 150 K и 200 K (b), T = 250 K и 300 K (c) в магнитном поле, приложенном параллельно оси легкого намагничивания.

направлению магнитного поля, приложенного в процессе изготовления образцов. Согласно существующим данным [13], основным механизмом, обусловливающим наведенную магнитную анизотропию, является парное упорядочение атомов. Кроме того, было установлено, что форма петель гистерезиса, наблюдаемая в магнитном поле, приложенном параллельно ЕА, зависит от линейных размеров изучаемых образцов. На рис. 1 и 2 приведены типичные петли гистерезиса, наблюдаемые для образцов размером $5 \times 5 \,\mathrm{mm}$ и $10 \times 10 \,\mathrm{mm}$ при комнатной температуре в магнитном поле, приложенном параллельно ЕА.

На рис. 3 приведены зависимости поля насыщения от толщины гадолиниевого слоя, наблюдаемые для Co/Gd/Co образцов с линейными размерами 5×5 и 10×10 mm.

Анализ данных, приведенных на рисунках 1–3, показал следующее. Поле насыщения, H_S , изучаемых, образцов зависит от толщины гадолиниевого слоя. Наиболее сильное изменение H_S (в частности, уменьшение) наблюдается для обеих серий образцов при $t_{\rm Gd} = 10.0$ nm. Для образцов размером 5 × 5 mm в отличие от образцов 10×10 mm осцилляции значений $H_{\rm S}$ с ростом толщины гадолиниевого слоя менее заметны. Обнаруженные для обеих серий изучаемых образцов зависимости $H_{\rm S}$ от толщины гадолиния были объяснены наличием обменного взаимодействия между слоями кобальта через прослойку гадолиния [10].

Особого внимания заслуживают петли гистерезиса, наблюдаемые при низких температурах для Co/Gd/Co образцов с линейными размерами 5×5 mm, приведенные на рис. 4-7.

Результаты приведенных выше измерений позволяют получить информацию о значениях поля насыщения, H_S , коэрцитивной силе, H_C , и величине магнитного момента изучаемых образцов, а также оценить влияние температуры на указанные выше магнитные характеристики. Однако следует отметить, что анализ полученных экспериментальных данных свидетельствовал о том, что при T = 100 К намагниченность насыщения и поле насыщения H_S не всегда достигаются. В связи с этим ниже на рис. 8 и 9 приведены только зависимости коэрцитивной силы и магнитного момента при изменении температуры от 100 до 300 К.



Рис. 6. Петли гистерезиса, наблюдаемые для образца с $t_{\text{Gd}} = 6.0 \text{ nm}$ при T = 100 K и 150 K (*a*), T = 200 K и 230 K (*b*) и T = 250 K и 300 K (*c*) в магнитном поле, приложенном параллельном оси легкого намагничивания.



Рис. 7. Петли гистерезиса, наблюдаемые для образца с $t_{Gd} = 9.0$ nm при T = 100 K, 150 K и 200 K (*a*) и T = 250 K и 300 K (*b*) в магнитном поле, параллельном оси легкого намагничивания.



Рис. 8. Зависимости коэрцитивной силы $H_{\rm C}$ от температуры, наблюдаемые для образцов с различной толщиной Gd слоя в магнитном поле, параллельном оси легкого намагничивания. *a*) $t_{\rm Gd} = 3.0$ nm и $t_{\rm Gd} = 4.6$ nm; *b*) $t_{\rm Gd} = 6.0$ nm и $t_{\rm Gd} = 9.0$ nm.



Рис. 9. Зависимости магнитного момента *m* от температуры, наблюдаемые для образцов с различной толщиной Gd слоя в магнитном поле, параллельном оси легкого намагничивания. *a*) $t_{Gd} = 3.0$ nm и $t_{Gd} = 4.6$ nm; *b*) $t_{Gd} = 6.0$ nm и $t_{Gd} = 9.0$ nm.

Анализ данных, приведенных на рис. 8, показал следующее. Значения коэрцитивной силы изучаемых образцов с увеличением температуры от 100 до 300 К уменьшаются. Обнаруженное изменение $H_{\rm C}$ при T > 100 К подобно наблюдаемым для Fe/Gd и Co/Gd образцов в работах [14] и [15], соответственно. Согласно существующим данным, опубликованным в работах [14,15], такая зависимость $H_{\rm C}(T)$ свидетельствует о ферримагнитном характере изучаемых трехслойных систем, обусловленном изменением суммарного магнитного момента при изменении температуры [15].

Вместе с тем приведенные на рис. 9 зависимости магнитных моментов *m* от температуры свидетельствуют о наличии следующих особенностей. Образцы с толщиной гадолиния 4.6 и 6.0 nm характеризуются практически линейным ростом магнитных моментов с увеличением температуры. При этом значения *m* при $T = 100 \,\mathrm{K}$ совпадают, а при $T = 300 \,\mathrm{K}$ различаются. Кроме того, значение *m* при $t_{\mathrm{Gd}} = 6.0 \,\mathrm{nm}$ больше, чем при $t_{\mathrm{Gd}} = 4.6 \,\mathrm{nm}$. Чтобы объяснить этот факт, были измерены магнитные моменты образцов при комнатной температуре с различной толщиной гадолиниевого слоя. Результаты измерения приведены на рис. 10.

Анализ данных, приведенных на рис. 10, показал следующее. Магнитный момент образца с толщиной слоя гадолиния $t_{Gd} = 6.0$ nm больше, чем при $t_{Gd} = 4.6$ nm. Причиной такого поведения является наличие обменного взаимодействия между слоями кобальта и гадолиния. Подобная разница магнитных моментов сохранятся при T > 100 K, что и предопределяет увеличение магнитных моментов *m* при $t_{Gd} = 6.0$ nm по сравнению с образцом с $t_{Gd} = 4.6$ nm.



Рис. 10. Зависимость магнитного момента *m* от толщины слоя гадолиния при комнатной температуре.

Из рис. 10 видно, что магнитные моменты образцов с толщиной гадолиния 3.0 и 9.0 nm также различаются. При этом магнитный момент образца с толщиной гадолиния 3 nm значительно больше, чем для образца с $t_{\rm Gd} = 9.0$ nm. Кроме того, для этих образцов наблюдается более сложная зависимость магнитных моментов от температуры. В частности, для образца с $t_{\rm Gd} = 9.0$ nm при T = 150 K наблюдается точка компенсации магнитных моментов, а для образца с $t_{\rm Gd} = 3.0$ nm — уменьшение *m* примерно на 38% по сравнению с магнитным моментом при T = 300 K.

Наконец, необходимо отметить следующий важный факт. Известно, что согласно существующим данным [16], изменение значений магнитного момента кобальта при увеличении температуры в диапазоне от 100 до 300 К не превышает 10%. Это означает, что обнаруженное экспериментально уменьшение магнитного момента Co/Gd/Co изучаемых образцов с ростом толщины гадолиния определяется в основном его вкладом в суммарный магнитный момент образцов.

4. Заключение

В диапазоне температур от 100 до 300 К были экспериментально исследованы зависимости магнитных свойств и магнитополевого поведения низкоразмерных тонкопленочных Co/Gd/Co трехслойных систем, состоящих из двух одинаковых по толщине слоев кобальта и редкоземельной гадолиниевой прослойки разной толщины. Было обнаружено, что магнитополевое поведение образцов зависит от температуры и толщины образцов. В частности, для изучаемых тонкопленочных систем с толщиной гадолиния 4.6 и 6.0 nm наблюдался рост значений магнитного момента, *m*, при увеличении температуры от 100 до 300 К. При этом значение *m* для образца с $t_{\rm Gd} = 6.0$ nm было больше, чем для образ-

 детельствовало о ферримагнитном характере изучаемой трехслойной системы.
Выше описанные результаты проведенных исследований могут быть полезны при разработке новых тонкопленочных систем на основе переходных и редкоземельных металлов для практических применений в современных устройствах микро- и наноэлектроники, а также спинтроники.
Благодарности Авторы выражают благодарность В.Н. Лепаловскому за получение Со/Gd/Со тонкопленочных образцов.

Финансирование работы

Работа выполнена при финансовой поддержке из госбюджета, раздел 0110 (для тем по госзаданию) в рамках НИР "Фундаментальные проблемы физики магнитных наносистем".

ца с $t_{Gd} = 4.6$ nm. Этот факт был объяснен наличием обменного взаимодействия между слоями кобальта и гадолиния и его немонотонной зависимостью от тол-

щины гадолиниевого слоя. Для образца с толщиной гадолиния 9.0 nm при температуре, равной 150 K, была

обнаружена точка компенсации магнитных моментов,

а для образца с $t_{\rm Gd} = 3.0\,\rm nm$ наблюдалось уменьшение

магнитного момента *m* примерно на 38%, по сравнению с образцом при T = 300 К. Эти данные были объяснены

влиянием гадолиния на суммарный магнитный момент образцов. С увеличением температуры от 100 до 300 К

значения коэрцитивной силы, Н_С, уменьшаются, что сви-

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- T. Morishita, Y. Togami, K. Tsushima. J. Phys. Soc. Jpn. 54, 1, 37 (1985).
- J.B. Pelka, W. Paszkowicz, A. Wawro, L.T. Baczewski, O. Seeck. J. Alloys Compd. **328**, 1–2, 253 (2001).
- [3] E.E. Shalyguina, L.M. Bekoeva, N.I. Tsidaeva. Sens. Act. A 81, 1-3, 216 (2000).
- [4] Е.Е. Шалыгина, Л.В. Козловский, Ду Сяньбо, А.М. Ливенцов. Письма в ЖТФ 20, 20, 42 (1994).
- [5] L.T. Baczewski, M. Piecuch, J. Durand, G. Marchal, P. Delecroix. Phys. Rev. B 40, 16, 11237 (1989).
- [6] С.А. Никитин. Магнитные свойства редкоземельных металлов и их сплавов. МГУ, М. (1989). 247 с.
- [7] С.И. Воробьев, О.В. Шутылева, И.М. Пазуха, А.Н. Чорноус. ЖТФ 84, 11, 66 (2014).
- [8] A.M. Tishin, Y.I. Spichkin. The magnitocaloric effect and its applications. Institute of Physics Publishing, Bristol, Philadelphia. Taulor & Francis Group (CRC Press), Boka Raton, Florida (2016). 476 p.
- [9] C.W. Miller, D.V. Williams, N.S. Bingham, H.J. Srikanth. J. Appl. Phys. 107, 9, 09A903 (2010).

- [10] А.М. Харламова, А.В. Свалов, В.Н. Лепаловский, Е.Е. Шалыгина. ФТТ 61, 3, 460 (2019).
- [11] Н.С. Перов, В.В. Родионова, М.В. Прудникова, А.Б. Грановский, В.Н. Прудников. МГУ, М. (2016). 44 с.
- [12] И.Д. Родионов. Магнитные, магнитокалорические и магнитотранспортные свойства сплавов на основе Ni-Mn-In. МГУ, М. (2019). 142 с.
- [13] S. Chikazumi. Physics of Ferromagnetism. Oxford University Press, Oxford (2009). 668 p.
- [14] S. Demirtas, A.R. Koymen. J. Appl. Phys. 95, 9, 4949 (2004).
- [15] A.B. Chizhik, S.L. Gnatchenko, D.N. Merenkov, L.T. Baczewski, A. Wawro, H. Szymczak, H. Gamari-Seale. J. Appl. Phys. 84, 9, 5105 (1998).
- [16] P.J.H. Bloemen, W.J.M. de Jonge, F.J.A. den Broeder J. Magn. Magn. Mater. 93, 105 (1991).

Редактор Т.Н. Василевская